

| | |
|---|---|
| Unidade PÓS-GRADUAÇÃO ENGENHARIA ELÉTRICA | Área NANOELETRÔNICA E CIRCUITOS INTEGRADOS |
| Disciplina PEL103 – Dispositivos Semicondutores | Tipo Optativa |
| Carga Horária 4 horas semanais em 12 semanas | |
| Objetivos <p>Apresentar os principais dispositivos semicondutores utilizados em circuitos eletrônicos na atualidade e seus modelos físicos.</p> | |
| Metodologia Adotada Abordagem expositiva em sala de aula e uso de laboratório. | |
| Recursos necessários Sala de Aula. | |
| Programa para 12 semanas 1. Física dos Semicondutores; 2. Propriedades físicas dos semicondutores; 3. Junções PN; 4. Junções PN; 5. Capacitores MOS; 6. Capacitores MOS; 7. Capacitores MOS; 8. Transistores MOS; 9. Transistores MOS; 10. Transistores MOS; 11. Transistores Bipolares; 12. Transistores Bipolares. | |
| Método de Avaliação Provas e Trabalho final. | |
| Bibliografia Básica - Ben G. Streetman e Sanjay Banerjee, Solid State Electronic Devices, Prentice Hall, 1999. - Simon M. Sze, Physics of Semiconductor Devices, 2nd Edition. John Wiley and Sons, 1981. - J. P. Colinge e C. A. Colinge, Physics of Semiconductor Devices. Kluwer Academic Publishers, 2002. | |

Atualizada: 07/2011